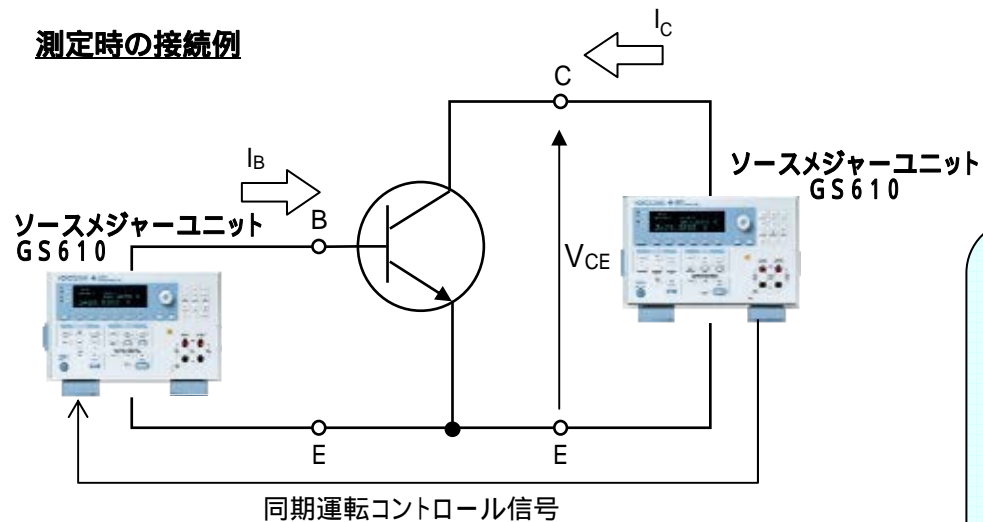


## 半導体デバイスの静特性測定(3端子)

### 概要

2台のGS610を同期運転してトランジスタの静特性を測定します。 $I_B$ - $I_C$ 特性の測定では下図のように、ベース電流 $I_B$ 出力用のGS610とコレクタ電流 $I_C$ 測定用のGS610を用意し、2台のユニットを同期運転して特性を測定します。 $V_{CE}$ - $I_C$ 特性の測定では、エミッタ-コレクタ間に本機を接続し $V_{CE}$ を印加してコレクタ電流 $I_C$ を測定します。

### 測定時の接続例



- ・ $V_{CE}$ - $I_C$ 特性 ( $h_{oe}$ )
- ・ $I_B$ - $I_C$ 特性 ( $h_{fe}$ )
- ・ $V_{BE}$ - $I_B$ 特性 ( $h_{ie}$ )
- ・ $V_{CE}$ - $V_{BE}$ 特性 ( $h_{re}$ )

### 特長

- 汎用ワークシートの利用が可能なカーブトレース機能
- 従来のカーブトレースに比べ非常に安価(約1/4の価格)
- 最大電圧110V、最大電流3.2Aでのカーブトレースが可能
- 電圧基本確度 $\pm 0.02\%$ 、電流基本確度 $\pm 0.03\%$
- コントロールソフトウェアは不要
- 簡単接続、簡単設定による複数台同期運転

